

2SD256, 2SD257, 2SD258, 2SD259

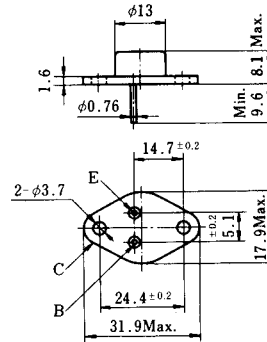
■シリコンNPN両面拡散形トランジスタ

- 一般用
- 通信産業用
- 指定通信工業用品種

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	60V	90V	110V	130V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	40V	60V	80V	100V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	6V			
コレクタ電流	I _C	4A			
ベース電流	I _B	1A			
許容コレクタ損失	P _C	25W (フランジ温度25°C)			
接合部温度	T _j	150°C			
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150°C			

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC (TO-66), EIAJ (TC-16A, TB-23)



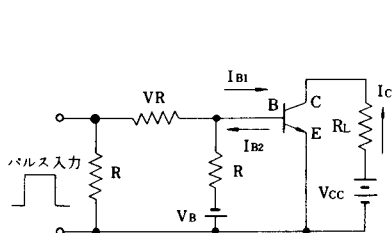
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
最大コレクタしゃ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 20V	10μA			
最大エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = 5V	200μA			
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	I _C = 50mA	40V	60V	80V	100V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = 4V I _C = 1A	40Min. 80Typ.			
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 2A I _B = 0.4A	1.0V Max. 0.2V Typ.			
しゃ断周波数	f _{αb}	V _{CB} = 10V I _E = -0.2A	8MHz Typ. 4MHz Min.			

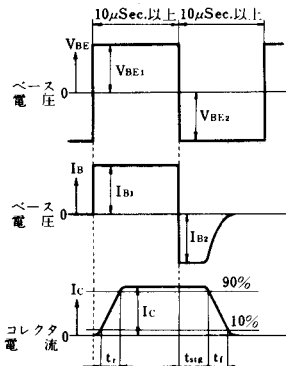
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
6	3	2	400	-100	1.2	1.6	1.7

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

